

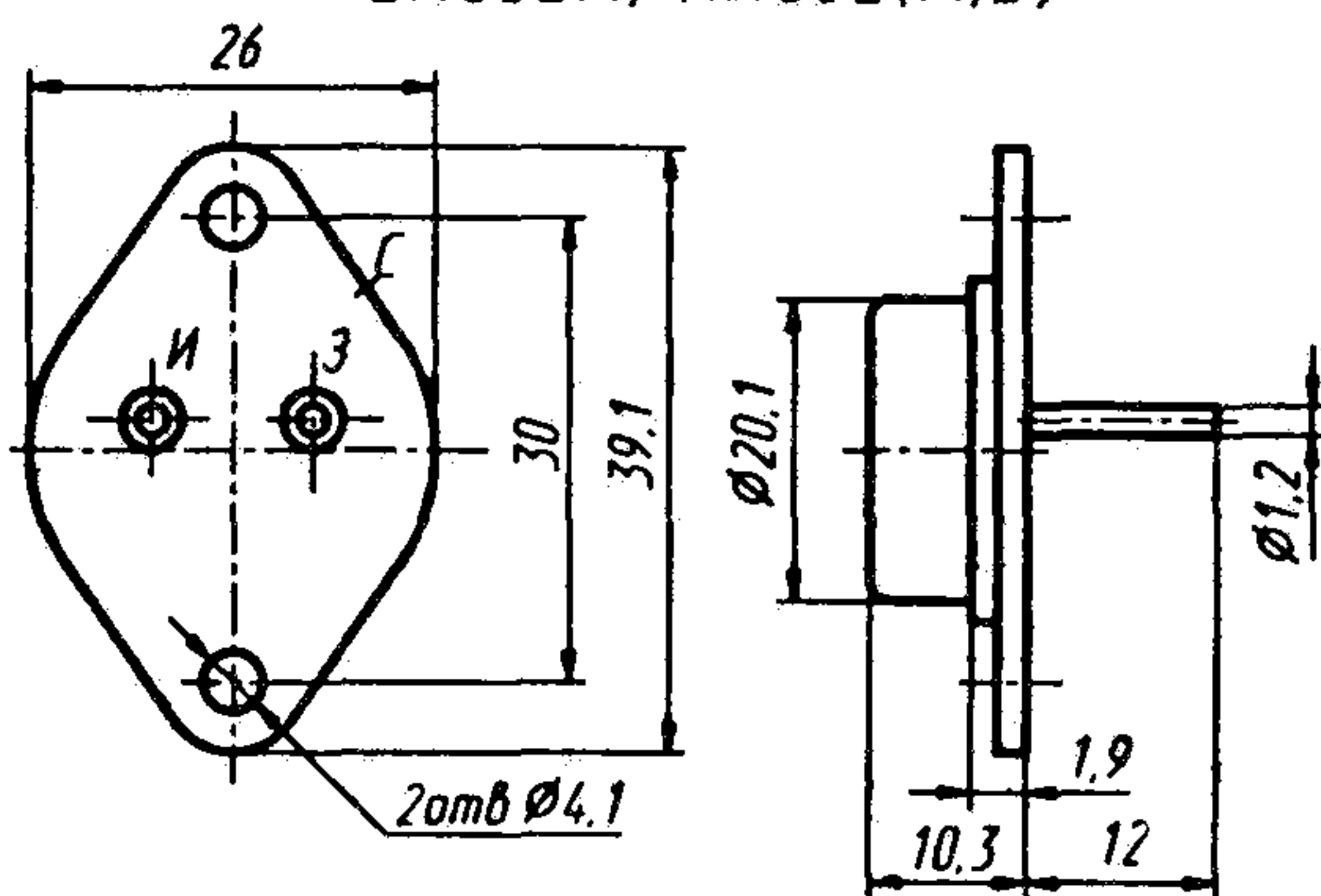
2П802А, КП802А, КП802Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе p - n перехода и вертикальным каналом n -типа переключательные. Предназначены для применения в преобразователях постоянного напряжения, быстродействующих переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе со стеклянными изоляторами и жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 20 г.

Изготовитель — НРП «Октава», г. Новосибирск.

2П802А, КП802(А,Б)



Электрические параметры

Сопротивление сток—исток в открытом состоянии при $I_C = 1$ А, $I_3 = 10$ мА, не менее	3 Ом
типичное значение	1,5* Ом
Крутизна характеристики при $U_{СИ} = 20$ В, $I_C = 3,5$ А, не менее	0,8 А/В
типичное значение	2* А/В
Напряжение отсечки при $U_{СИ} = 500$ В, $I_C = 3$ мА:	
2П802А, КП802А, не менее	—25 В
типичное значение	—18* В
КП802Б, не менее	—28 В
Время включения при $U_{СИ} = 300$ В, $I_C = 2$ А, не более	80 нс
типичное значение	40* нс

Время выключения при $U_{СИ} = 300 \text{ В}$, $I_C = 2 \text{ А}$, не более	30 нс
типовое значение	15* нс
Ток утечки затвора при $U_{ЗИ} = U_{ЗИ, \text{МАКС}}$ $T = +25 \text{ °С}$:	
2П802А, КП802А, не более	0,3 мА
типовое значение	0,01* мА
КП802Б, не более	0,7 мА
$T = -60$ и $+125 \text{ °С}$ для 2П802А	10 мА
Остаточный ток стока при $U_{СИ} = 400 \text{ В}$, $U_{ЗИ} = -25 \text{ В}$, не более	0,5 мА
Ток обратно смещенного $p-n$ перехода сток—затвор при $U_{ЗС} = U_{ЗС, \text{МАКС}}$, не более	1 мА

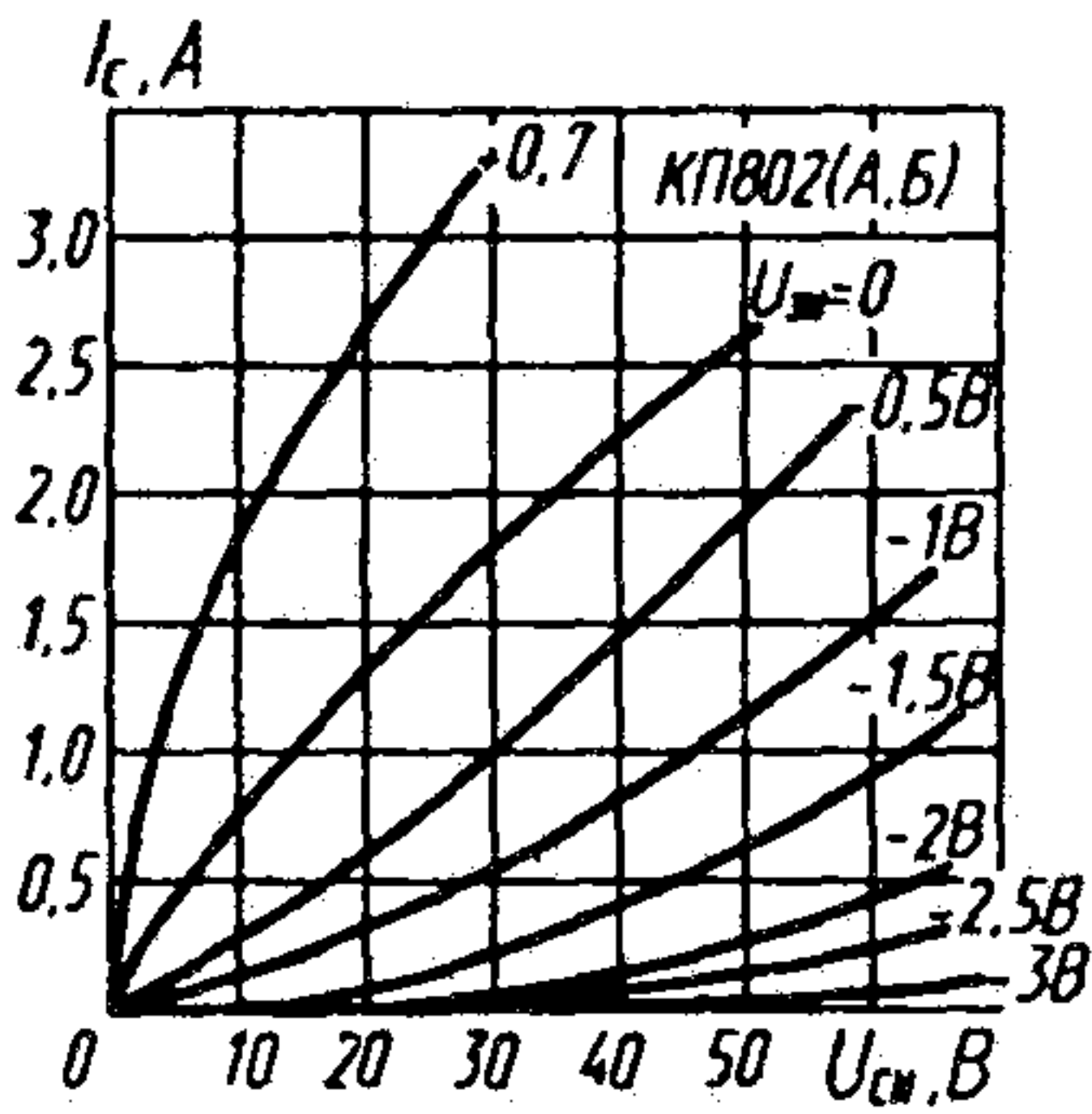
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток:	
2П802А, КП802А	500 В
КП802Б	450 В
Постоянное напряжение затвор—сток:	
2П802А, КП802А	535 В
КП802Б	480 В
Постоянное напряжение затвор—исток:	
2П802А, КП802А	-35 В
КП802Б	-30 В
Ток стока	2,5 А
Прямой ток затвора	1 А
Постоянная рассеиваемая мощность ¹ при $T_K = -60 \dots +25 \text{ °С}$	40 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	3,1 °С/Вт
Температура окружающей среды:	
2П802А	-60... $T_K =$ = +125 °С
КП802А, КП802Б	-45... $T_K =$ = +85 °С

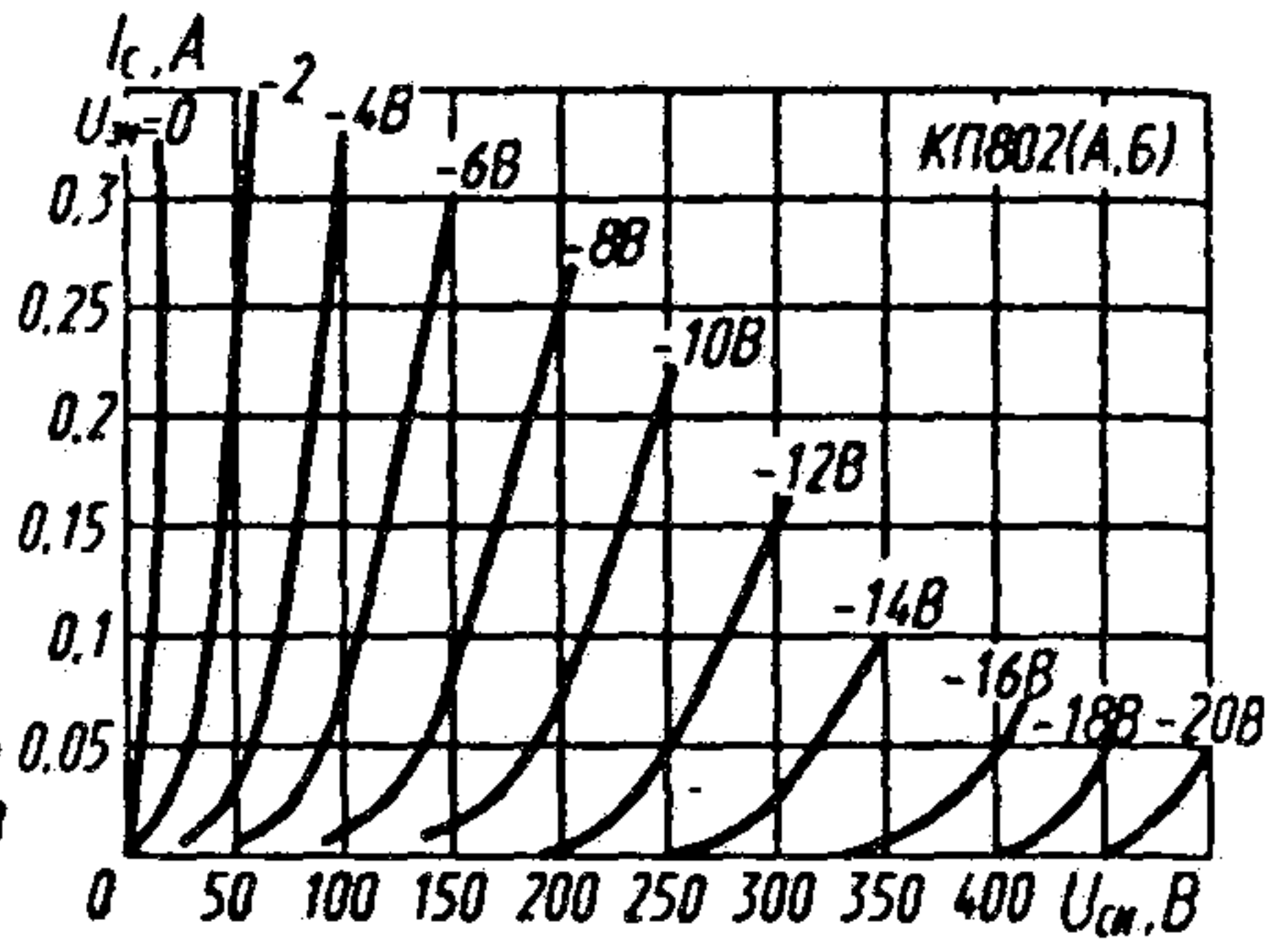
¹ При $T_K > +25 \text{ °С}$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность рассчитывается по формуле

$$P_{С, \text{МАКС}} = 40 [1 - (T_K - 25)/125], \text{ Вт.}$$

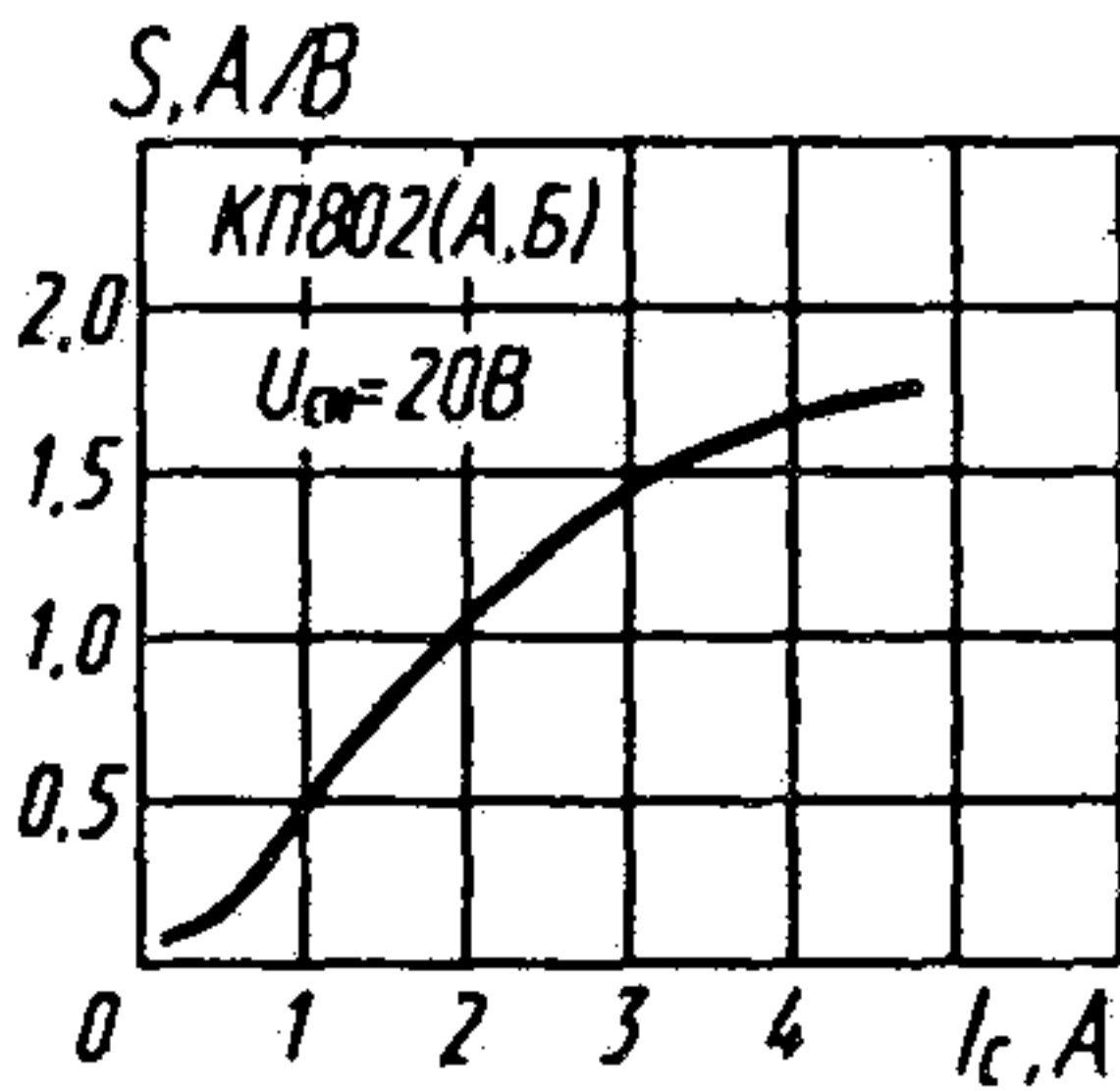
Пайка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора.



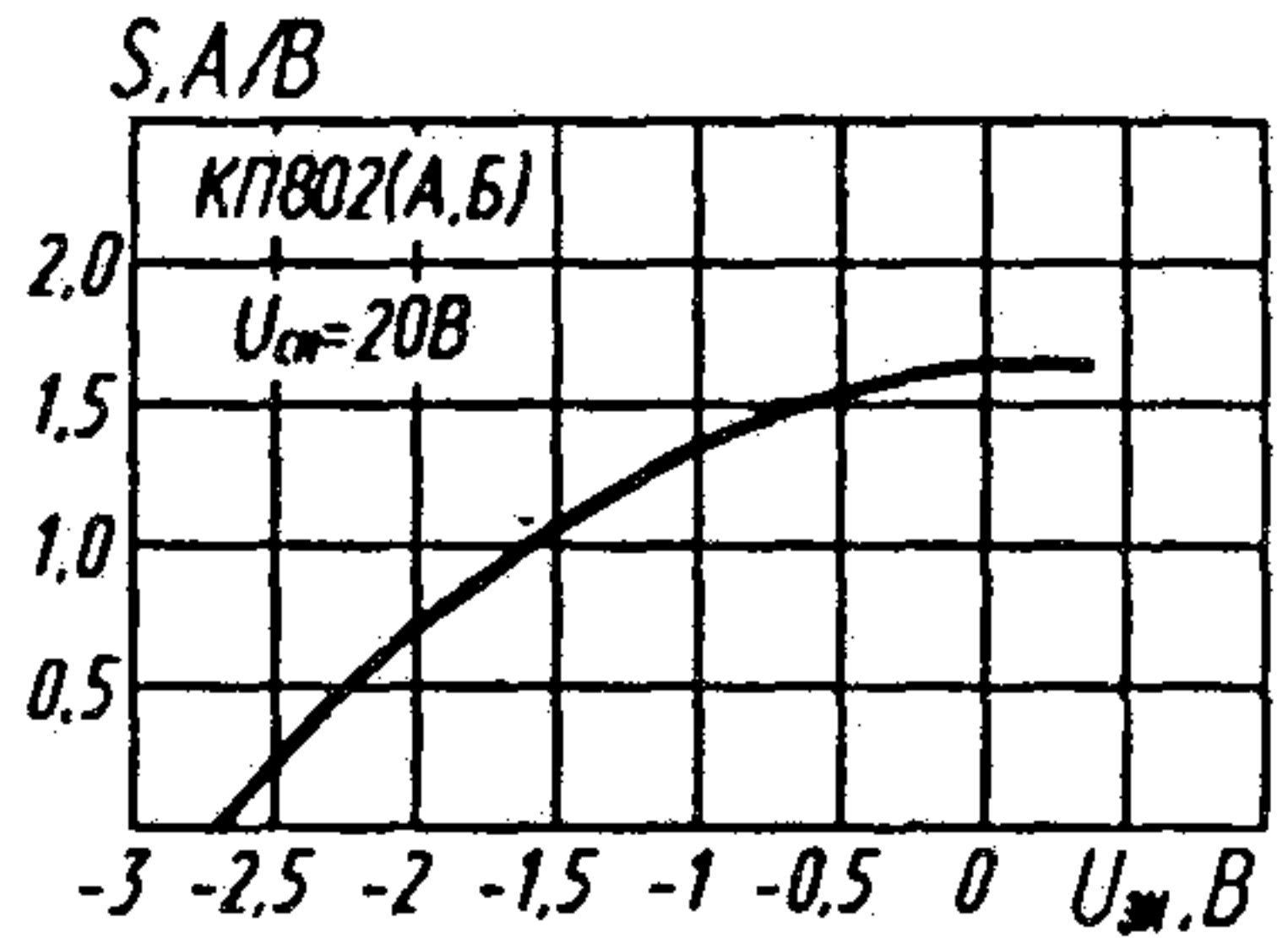
Зависимости тока стока от напряжения сток—исток (начальный участок по напряжению)



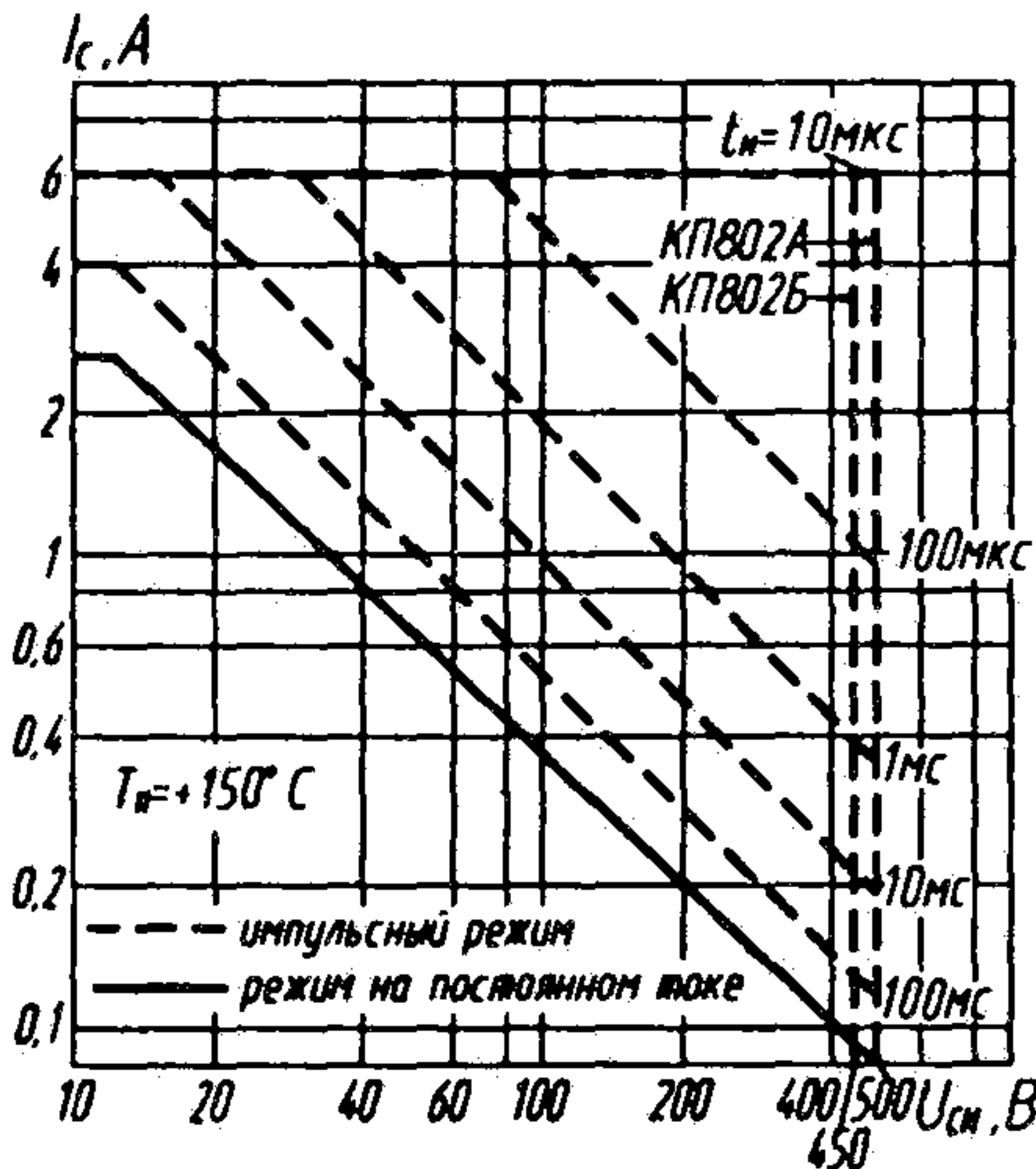
Зависимости тока стока от напряжения сток—исток (начальный участок по току)



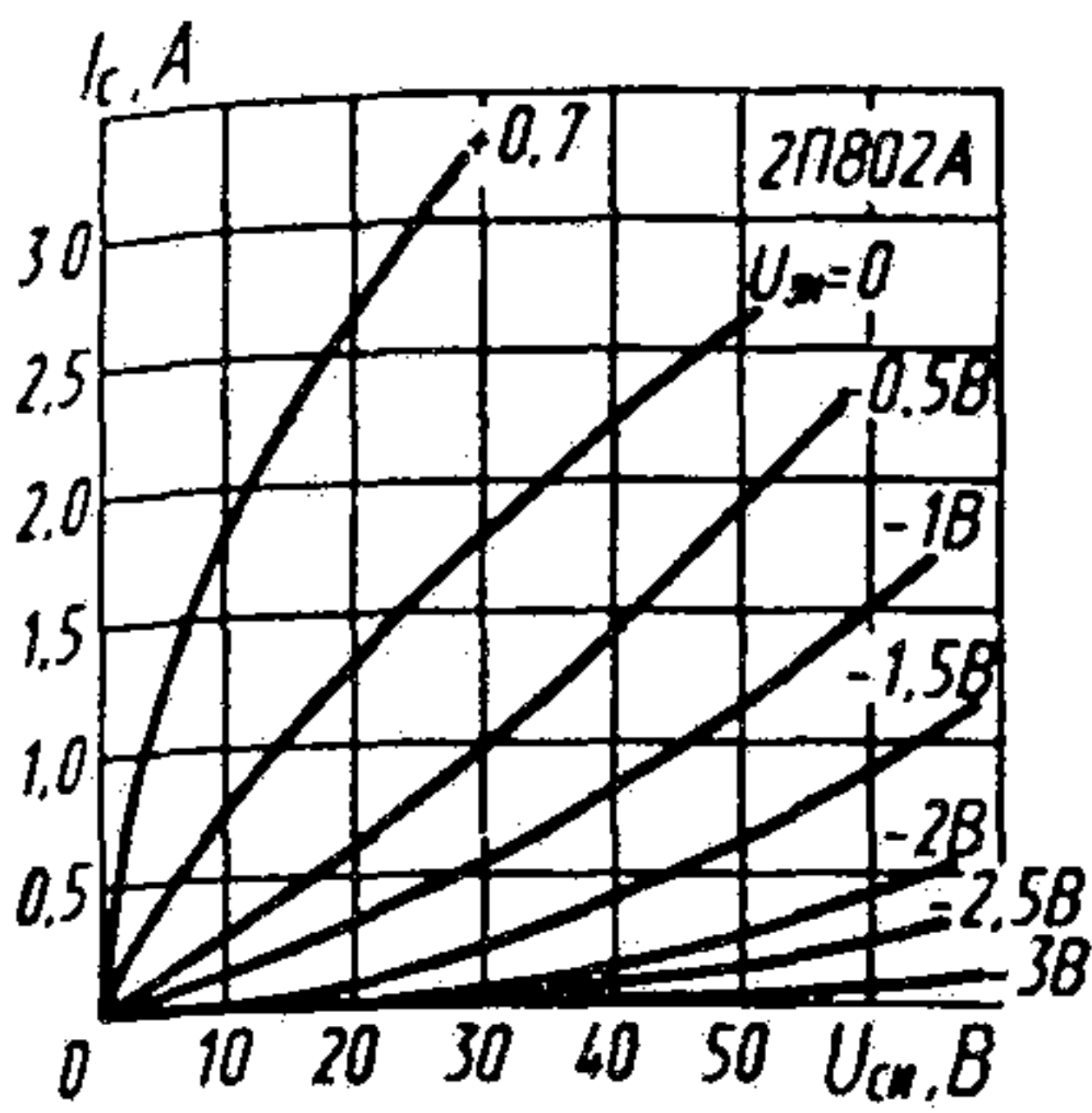
Зависимость крутизны характеристики от тока стока



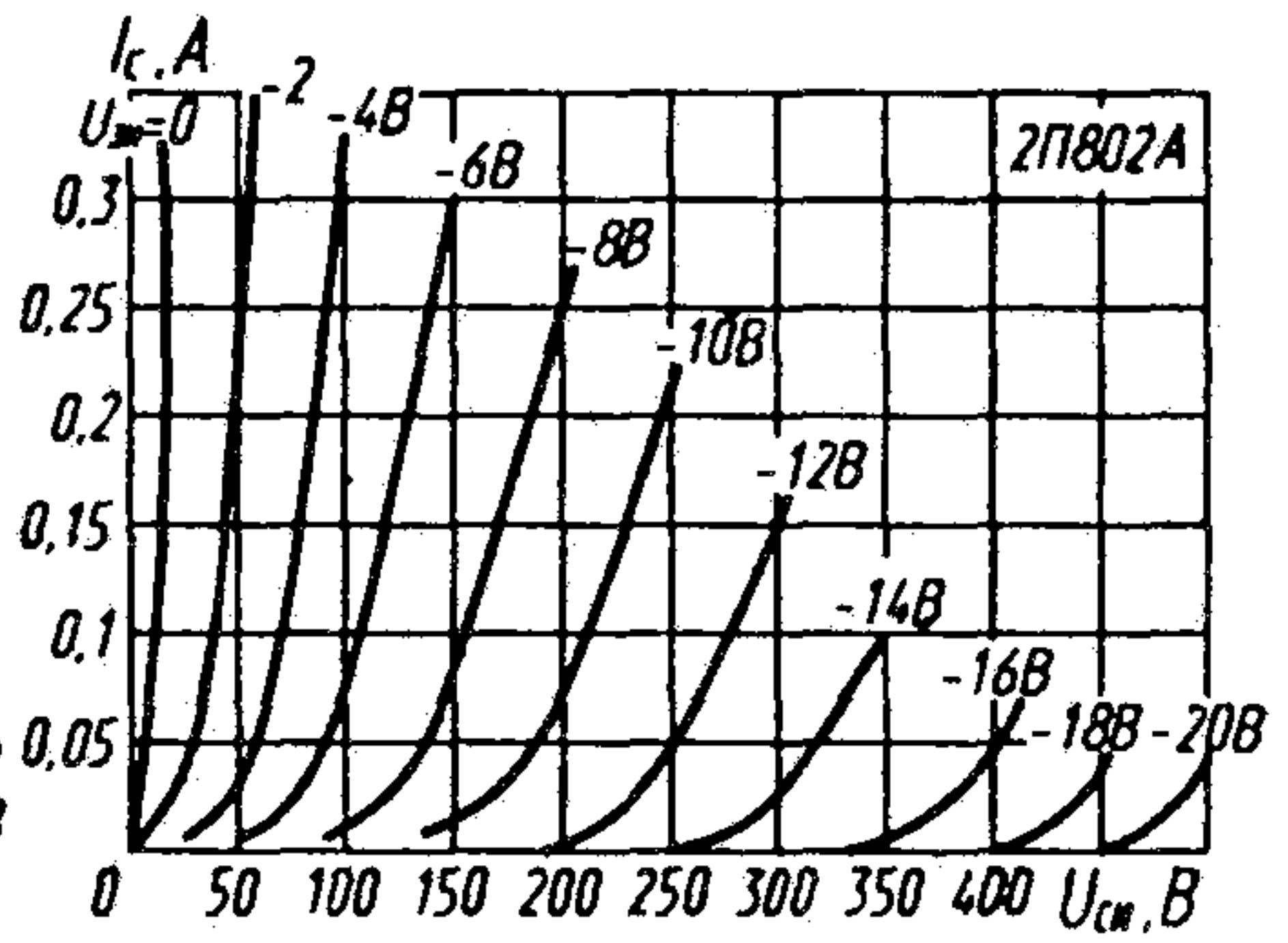
Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор—исток



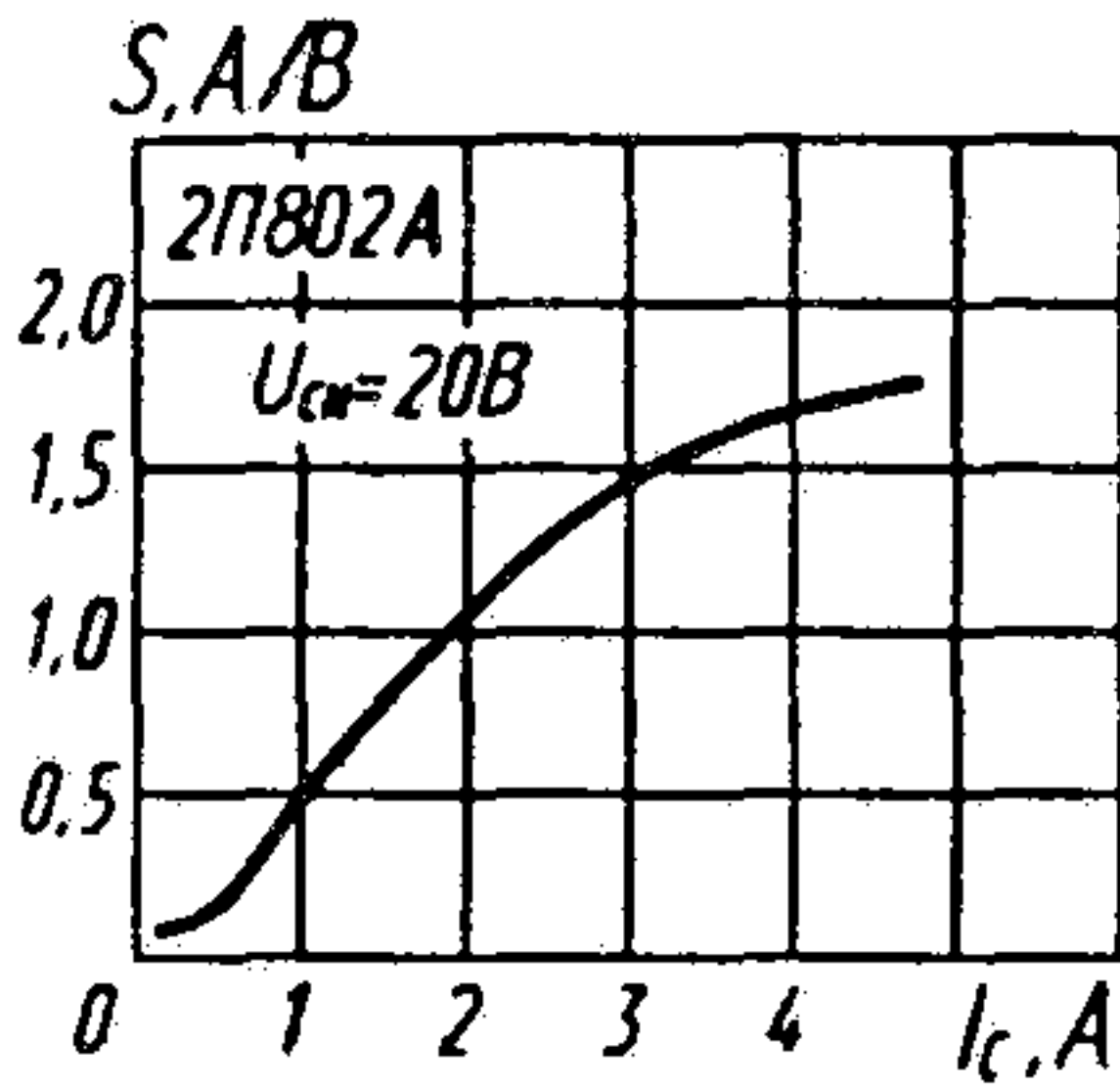
Области максимальных режимов



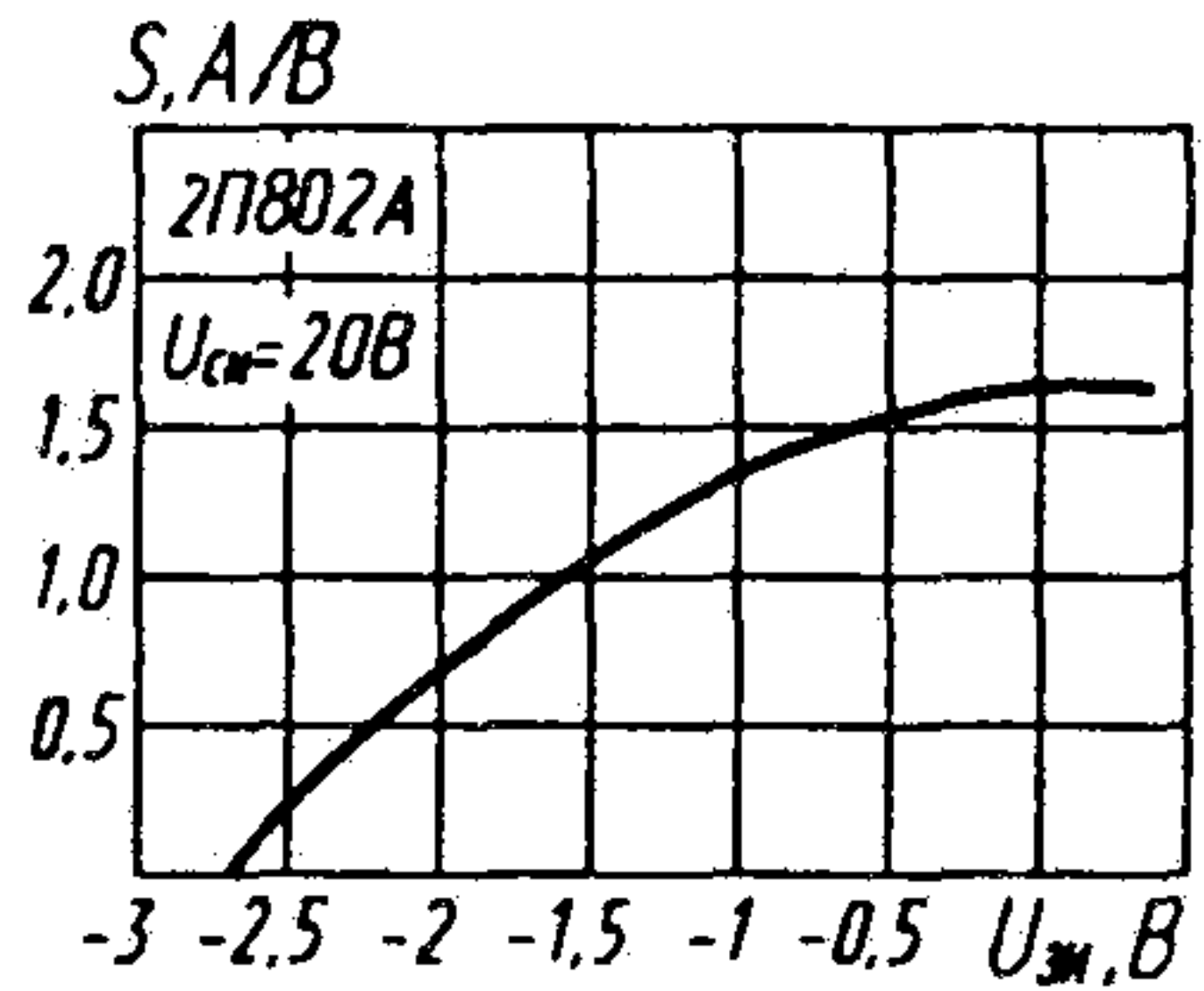
Зависимости тока стока от напряжения сток—исток (начальный участок по напряжению)



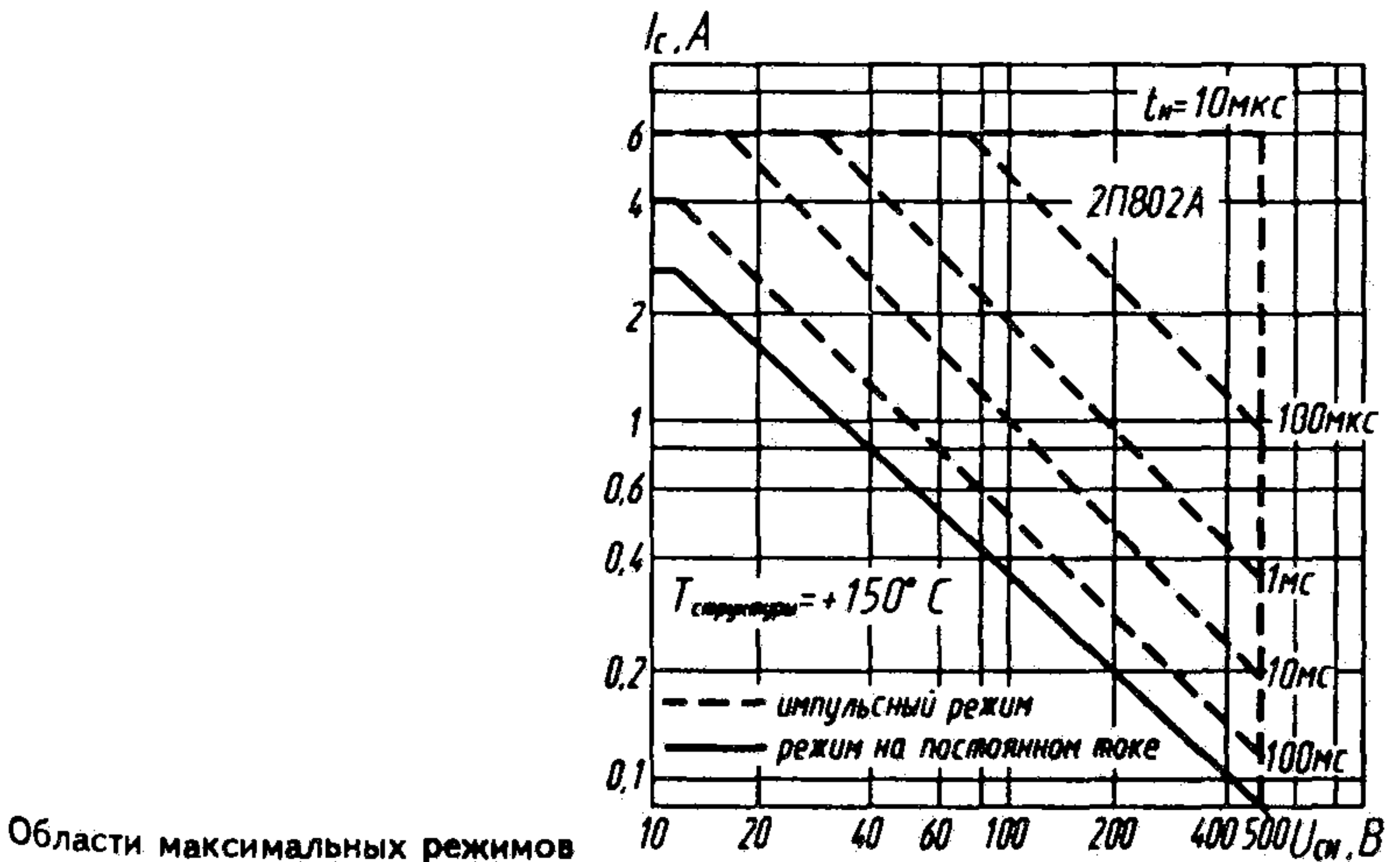
Зависимости тока стока от напряжения сток—исток (начальный участок по току)



Зависимость крутизны характеристики от тока стока



Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор—исток



Области максимальных режимов